

製作氮化鎵基板之方法

本院覽號

26A-980115

公告日期

智財權狀態

美國US 8133803 B2放棄維護、台灣(發明)I427699放棄維護

摘要

此專利為製作大面積與低缺陷之三族氮化物半導體基板與其元件，在製作過程中利用氮化鎵與藍寶石介面中之六角型金字塔結構有效增加發光二極體之光萃取效率。利用此方法將氮化鎵與藍寶石基板分離並不需要用到雷射剝離法。

技術優勢

可以有效的提升光萃取效率，並可以將氮化鎵與藍寶石基板分離且不需要使用到雷射剝離之技術。

應用範圍

以氮化鎵基材之光電元件，例如 氮化鎵白光發光二極體，雷射二極體等

創作人

程育人、羅明華、郭浩中



中央研究院
ACADEMIA SINICA